

(2) P型輕摻雜汲極 (P-LDD) 之微影及三價原子植入，再把光阻移除，即形成 P-LDD，如圖 6-23 所示。

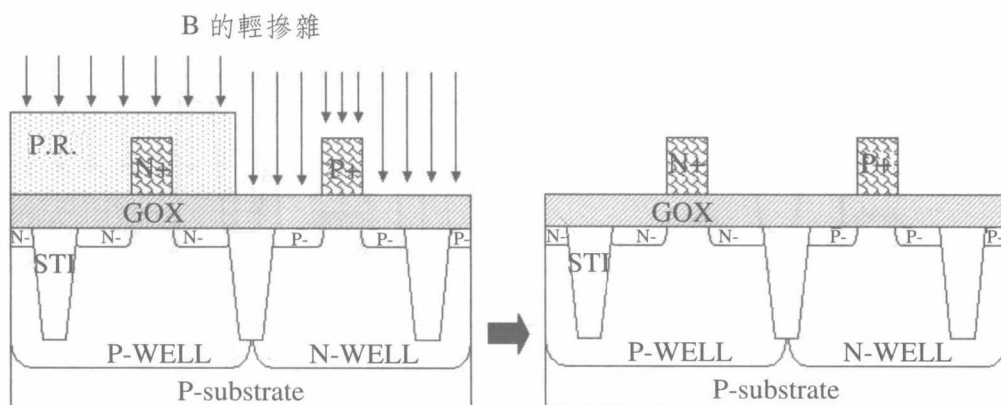


圖 6-23 P-LDD 之製作流程。

6. 側壁 (Spacer) 之形成

(1) 以化學氣相沉積 (CVD) 的方式沉積一層氧化層，如圖 6-24 所示。

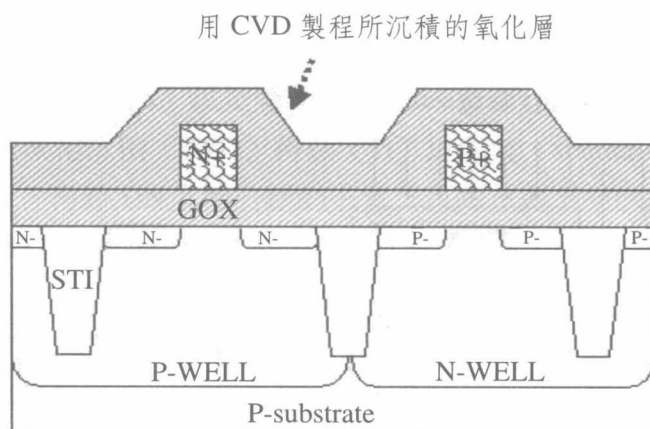


圖 6-24 側壁氧化層之沉積。

(2) 以乾電漿蝕刻的方式採以非等向性 (anisotropic) 的垂直蝕刻去除大部分的氧化層，直到蝕刻到 Si，此時選擇比 (selectivity) 已經很大了，停